## 清洁及单层吸附的Mo(001)表面 声子色散研究

## 资剑 张开明

(复旦大学物理系,上海,200433)

摘要——用最近邻及次邻中心相互作用势讨论了清洁的 Mo(001) 表面声子。 作为初步近似,用质量亏损模型讨论了不同吸附原子质量对表面声子的影响。

关键词——Mo(001),表面声子,质量亏损模型。

#### 1. 引言

近年来,关于表面声子的实验探测发展迅速,电子能量损失谱(EELS)<sup>[1]</sup>和 He 原子散射<sup>[2]</sup>在测量表面声子方面取得了很大成功。由于第一性原理计算表面声子非常困难,绝大多数表面声子的计算使用的是经验方法,经验模型在计算表面声子方面是比较成功的<sup>[3~5]</sup>。

Mo 和 W 是理论和实验都研究得比较多的 boo 结构的过渡金属,最近实验上对 W(001)<sup>161</sup>和 W(110)<sup>171</sup>表面的声子进行了测量。由于实验技术的限制,表面声子的许多模式还无法测量,从理论上进行研究仍是十分有意义的。对于不同吸附原子,吸附原子之间 及吸附原子与衬底之间的相互作用是很难确定的。作为初步近似,本文用质量亏损模型<sup>181</sup>讨论单层吸附后、由于吸附物质量不同而引起的表面声子变化。

#### 2. 计算模型

本文选取的相互作用势考虑最近邻和次近邻中心相互作用,即

$$V_{i}(R) = V_{i}^{0} + R_{i}^{02} \left[ \alpha_{i} \left( \frac{R}{R_{i}^{0}} - 1 \right) + \frac{1}{2} \beta_{i} \left( \frac{R}{R_{i}^{0}} - 1 \right)^{2} \right], \tag{1}$$

其中

$$\alpha_{i} = \frac{1}{R} \left. \frac{\partial V_{i}}{\partial R} \right|_{R=R_{i}^{0}} , \quad \beta_{i} = \frac{\partial^{2} V_{i}}{\partial R^{2}} \right|_{R=R_{i}^{0}}$$
 (2)

代表相互作用参数,i=1, 2 分别代表最近邻及次近邻,  $R_i^0$  是第 i 近邻的平衡距离. 从平衡条件可以得出  $\alpha_1 = -\alpha_2$ , 这样, 共有  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  和  $\beta_2$  3 个参数, 用这 3 个参数拟合 Mo 的体声子  $-\frac{1}{4 \times 1989 \pm 3}$  月 9 日收到。

曲线<sup>[9]</sup>. 可以确定这 3 个参数值 为  $\alpha_1 = -\alpha_2 = 2.54 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$ ,  $\beta_1 = 260 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$ ,  $\beta_2 = -2.54 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$ ,  $\beta_3 = -2.54 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$ ,  $\beta_4 = -2.54 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$ ,  $\beta_5 = -2.54 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$   $\beta_5 = -2.54 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$   $\beta_5 = -2.54 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$   $\beta_5 = -2.54 \,\mathrm{eV}/(\mathrm{nm})^2$ 

309eV/(nm)<sup>2</sup>. 图 1 比较了拟合结果与实验测量结果,从图中可以看出,计算值与实验值符合得比较好.

由于吸附原子之间及吸附原子与衬底之间的相互作用很难确定,本文用质量亏损模型<sup>183</sup>作为初步近似来讨论单层吸附原子在Mo(001)表面的吸附情况,并认为所有的相互作用与体内相同,不同吸附原子造成的差别仅仅是质量上的差异. 吸附原子的质量记为 m, Mo 原子的质量记为 M. 选取 15 个原子层模型模拟表面吸附, 其本征方程为

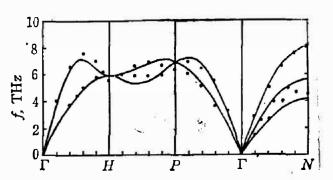


图 1 拟合计算的 Mo 体声子与实验值的比较(黑点代表实验值)

Fig. 1 The comparison between fitted bulk Mo phonons and the experimental results.

$$\sum_{l'\nu} D_{\mu\nu}^{ll'}(\boldsymbol{q}) \xi_{\nu}(l', \boldsymbol{q}) = \omega^{2}(\boldsymbol{q}) \xi_{\mu}(l, \boldsymbol{q}), \qquad (3)$$

式中 $\xi_{\mu}(l)$ 代表 l 层原子沿 $\mu$ 方向的极化,满足归一化条件, $D_{\mu\gamma}^{ll}$  是动力学矩阵元,有

$$D_{\mu\nu}^{ll'}(\boldsymbol{q}) = \frac{1}{\sqrt{MlMl'}} \sum_{l'', \boldsymbol{r}_{i}(ll'')} \left[ \alpha_{i} \delta_{\mu\nu} + (\beta_{i} - \alpha_{i}) \frac{R_{i}^{0} {}_{\mu} R_{i}^{0\nu}}{|\boldsymbol{R}_{i}^{0}|^{2}} \times (\delta_{ll'} - \boldsymbol{e}^{i\boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{r}_{i}(ll'')} \delta_{l'll''}) \right]$$

$$(4)$$

其中  $\mathbf{R}_{i}^{0} = \mathbf{r}_{i} + (la/2)\hat{\mathbf{Z}}$  是 l 层原子的位置矢置, a 是晶格常数,  $\hat{\mathbf{Z}}$  方向垂直于表面,  $\mathbf{r}_{i}$  是  $\mathbf{R}_{i}^{0}$  在 $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$  平面的投影. 当 l=1 和 l=15 时,  $M_{i}=m$ , 其它情况下,  $M_{i}=M$ . 对不同的  $\mathbf{q}$  解本征方程(3)就可得到声子曲线.

## 3. 清洁表面的声子

Mo(001)表面的二维布里渊区(SBZ)如图 2, 清洁表面相当于 m=M 的特殊情况、图

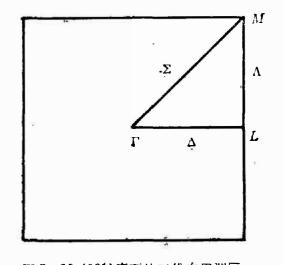


图 2 Mo(001)表面的二维布里渊区 Fig. 2 Two-dimensional Brillouin zone for Mo(001) surface.

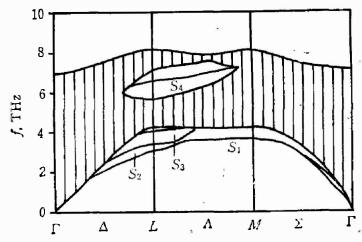


图 3 清洁 Mo(001)表面的声子色散曲线 Fig. 3 Phonon dispersions of clean Mo(001) surface.

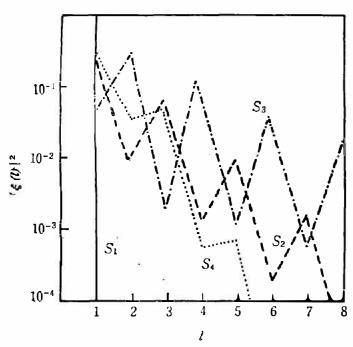


图 4  $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$ 、和  $S_4$  波在 L 点的平方振幅  $|\xi(l)|^2$  随原子层数 l 的衰减

Fig. 4 Attenuations of squared vibrational amplitudes  $|\xi(l)|^2$  of  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  and  $S_4$  vs layer index l at point L.

3 给出了 Mo(001) 表面沿  $\Delta$ 、  $\Lambda$  和  $\Sigma$  方向的声子曲线,其中阴影部分是体能带的投影. 图中表面波  $S_1$ 、  $S_2$ 、  $S_3$  和  $S_4$  都是两度简并的,这是因为薄层 型有两个表面的缘故. 在 q 很小的这是 对有两个表面的缘故. 在 q 很小的这是 由于两个表面相互耦合造成的. 只会 离 是数取得足够多,这种分裂将会 是数取得足够多,这种分裂将会 不 SBZ 区域, $S_2$ 、  $S_3$  和  $S_4$ .  $S_1$  存在于  $\Delta$  和  $\Delta$  方向 之间,而  $S_3$  主要存在于  $\Delta$  和  $\Delta$  方向 图 4 和图 5 分别给出了表面波的平方

$$\begin{split} |\bar{\xi}(l)|^2 &= |\bar{\xi}_x(l)|^2 \\ &+ |\bar{\xi}_y(l)|^2 + |\bar{\xi}_z(l)|^2 \end{split}$$

随原子层 1 的衰减情况, 从图中可以

看出, $S_1$ 、 $S_2$  和  $S_4$  波的振动振幅主要分布在第一层表面原子上,而  $S_3$  波的振幅则主要集中在第二层原子上。

在 $\Delta$ 方向上, $S_1$ 波是完全的切变水平 模式(Shear horizontal mode), 即振动方 向平行于表面且垂直于q方向;  $S_2$  波主要 是切变垂直模式 (Shear vertical mode), 即振动方向垂直于表面; $S_4$ 波主要是纵向 模式(Longitudinal mode),即振动方向沿 q 方向,在 L 点,  $S_1$  波的振幅完全落在第 一层原子上(参见图 4). 在  $\Lambda$  方向上发生 了一个有趣的现象,随着 q 从 L 点向 M点移动, $S_1$ 和  $S_2$  在彼此接近的地方相互交 换振动模式, S1 波从水平模式变成垂直模 式, $S_2$ 从垂直模式变成水平模式, $S_3$ 波在  $\Lambda$  方向主要是垂直模式,  $S_4$  波仍然是纵向 模式. 但随 q 向 M 接近, Sa 波的纵向模式 成份增加,在 $\Sigma$ 方向 $S_1$ 波主要是垂直模 式. 从以上分析可以看出, S2波(在 4 方 向)和  $S_1$  波(在  $\Lambda$  方向和  $\Sigma$  方向)是瑞利 波.

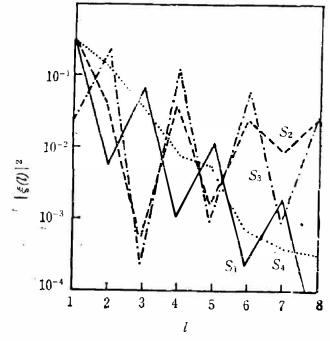


图 5  $S_1$ 、 $S_2$ 、 $S_3$  和  $S_4$  波在  $\Delta$  方向中点的平方振幅  $|\xi(l)|^2$  随原子层数 l 的衰减

Fig. 5 Attenuations of squared vibrational amplitudes  $|\xi(l)|^2$  of  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ , and  $S_4$  vs layer index l at the center of  $\Lambda$  direction.

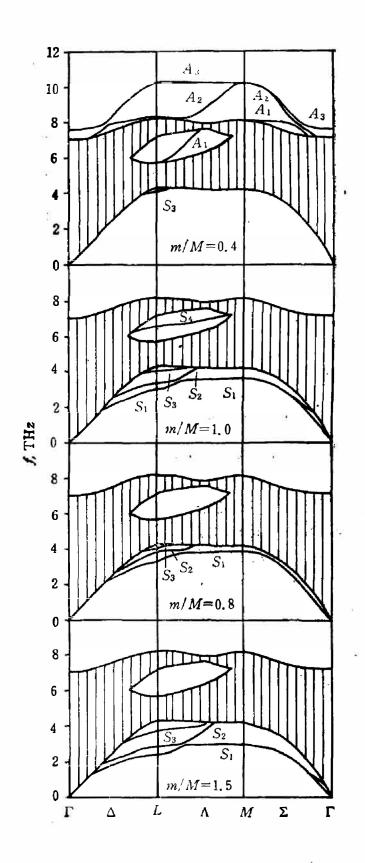


图 6 不同吸附原子质量 m/M = 0.4, 0.8, 1.0 和 1.5 的声子色散曲线(m/M = 1.0 对应于清洁表面) Fig. 6 Phonon dispersions for different values of ratio m/M = 0.4, 0.8, 1.0 and 1.5 (m/M = 1.0 corresponds to the clean surface).

## 4. 单层吸附表面的声子

本文用质量亏损模型处理 Mo(001)单层吸附表面的情况. 图 6 给出了m/M=0.4、0.8、1.0 和 1.5 的原子吸附后的声子曲线. 在轻质量原子吸附情况下(如 m/M=0.4),瑞利波存在于体带内,  $S_3$  波存在于 L 点很小的区域内, 并出现了  $A_1$ 、 $A_2$  和  $A_3$  表面波,由于  $q\to 0$  时  $A_1$ 、 $A_2$  和  $A_3$  波的振动频率不为零,故这 3 个表面波可以看成是表面光学波.  $A_3$  波存在于整个 SBZ 区域,  $A_2$  波存在于大部分 SBZ 区域. 对于更轻的原子吸附,  $A_1$ 、 $A_2$  和  $A_3$  波离体能带更高. 在  $\Gamma$  点,  $A_3$  波是完全的垂直模式. 在  $\Delta$  方向,随 q 由  $\Gamma$  点向 L 点靠近,  $A_3$  被 在接近的地方交换模式,  $A_3$  波由垂直模式变成纵向模式,  $A_2$  波由纵向模式变成垂直模式. 随着 q 由 L 点向 M 点靠近,  $A_3$  波仍然是纵向模式,但垂直模式有所增加. 在中点  $\Delta$  附近,  $\Delta$  和  $\Delta$  2 部分交换模式,  $\Delta$  2 波有纵向模式成份,  $\Delta$  1 变成纵向+水平模式. 在  $\Delta$  方向中点偏右处,  $\Delta$  3 同  $\Delta$  1 波部分交换模式.  $\Delta$  3 波拥有水平模式成份,并随着向  $\Delta$  1 法近水平模式增加,至  $\Delta$  1 点变成了完全的水平模式. 在  $\Delta$  5 方向中点的平方振幅随原子层的衰减情况.  $\Delta$  3 波和  $\Delta$  2 波振幅主要集中在表面原子上,而  $\Delta$  1 波的振幅主要集中在第二层原子上。

从图 6 还可以看出,在轻原子吸附情况下存在 3 个光学表面波. 随着吸附原子质量的增加,光学表面波消失,变为体带部分.  $S_1$ 、 $S_2$  和  $S_3$  波随吸附原子质量增大而愈来愈偏离体能带.  $S_4$  对吸附原子质量非常敏感,仅存在于 m/M=1 附近很小的范围内.

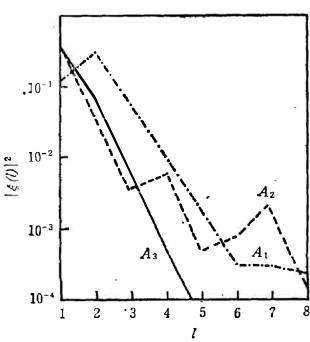


图 7  $A_1$ 、 $A_2$  和  $A_3$  波在 A 方向中点的平方振幅  $|\xi(l)|^2$  随原子层数 l 的衰减

Fig. 7 Attenuations of squared vibrational amplitueds  $|\xi(s)|^2$  of  $A_1$ ,  $A_2$  and  $A_3$  vs layer index l at the center of A direction.

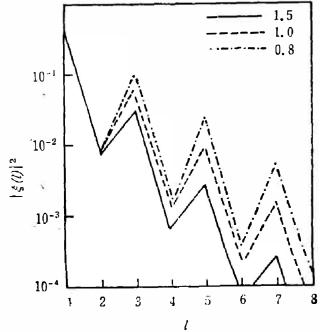


图 8  $S_1$  波 $\epsilon$  L 点的平方振幅  $|\xi(l)|^2$  随 m/M 的变化

Fig. 8 Attenuations of squared vibrational amplitueds  $|\xi(l)|^2$  of  $S_1$  vs layer index l for different values of ratio m/M at point L.

为了比较不同原子质量吸附对  $S_1$ 、 $S_2$  和  $S_3$  波振幅衰减情况的影响,图  $S_1$ 、 $S_2$  和  $S_3$  没在不同吸附原子质量下,振幅随原子层的衰减情况。 $S_1$  和  $S_2$  没的振幅主要分布在表面原子上,随着吸附原子质量的增加,平方振幅随原子层的衰减也越大。而  $S_3$  波的振幅主要分布在第二层原子上,随着吸附原子质量的改变,其平方振幅随原子层衡的衰减几乎没有变化。

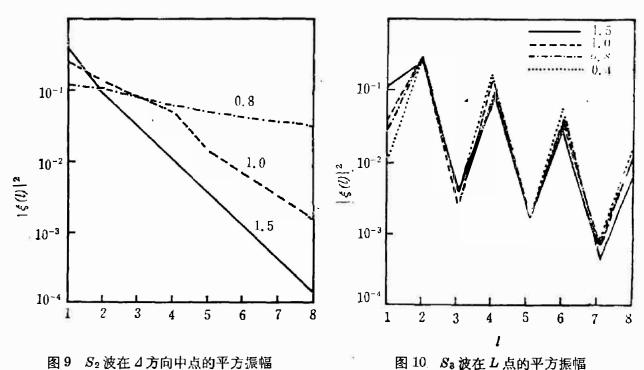


Fig. 9 Attenuations of squared vibrational amplitudes  $|\xi(l)|^2$  of  $S_2$  vs layer index l for different values of ratio m/M at the center of  $\Delta$  direction.

|ξ(l)|2 随 m/M 的变化

Fig. 10 Attenuations of squared vibrational amplitudes  $|\xi(l)|^2$  of  $S_3$  vs layer index l for different values of ratio m/M at point L.

 $|\xi(l)|^2$  随 m/M 的变化

#### 参考文献

- [1] Ibach H. and Rahman T. S., in 5th International Conference on Solid Surfaces, Ed by R. Vanselow and R. Howe, Vol. 35, P. 455, Springer, Berlin, 1985.
- [2] Toennies J. P., J. Vac. Sci. Technol., B2(1984), 1055.
- [3] Fasolino A. and Tosatti E., Phys. Rev., B35(1987), 4264.
- [4] Black J. E. et al., Surf. Sci., 115(1982), 161.
- [5] Black J. E. et al., Surf. Sci., 192(1987), 541.
- [6] Ernst H. J., Hulpke E. and Tonnies J. P., Phys. Rev. Lett., 58(1987), 1941.
- [7] Smith R. J. et al., Phys. Rev. Lett., 58(1987), 702.
- [8] Alldrege G. P., Allen R. E. and deWette F. W., Phys. Rev., B4 (1971), 1682.
- [9] Zarestky J. et al., Phys. Rev., B28(1983), 697.

# STUDY ON PHONON DISPERSION OF CLEAN AND MONOLAYER ADSORBED Mo (001) SURFACE

ZI JIAN, ZHANG KAIMING
(Department of Physics, Fudan University, 200433, Shanghai, China)

#### ABSTRACT

Using the nearest and next nearest neighbor central interactions, phonons of clean Mo(001) surface are studied. As a primary approximation, the effects of different adsorbed atom masses on surface phonons are discussed by a simple mass defect model.